

## Revolution by Evolution: Getting to the Next Technology Breakthrough in Analog Simulation

Art Schaldenbrand, Senior Product Marketing Manager, Cadence

近年のテクノロジーの進歩、Advanced Node の使用や More than Moore デザインにより、アナログ設計者やカスタム IC の設計者は、これらの進歩から恩恵を受ける新しい設計方法を受け入れなければなりません。これらの変更により、さらに多くのポストレイアウトの寄生情報を持った大規模デザインをシミュレーションする必要性が生まれました。また、フラッシュ・メモリー、MRAM、センサー・アレイなどの多くのカスタム IC デザインは SPICE 精度のシミュレーションが求められます。これらの要望を満たすには、現世代の回路シミュレータよりもはるかに高い性能と規模に対応した新世代の SPICE エンジンが必要です。次世代の Spectre®回路シミュレータである Cadence® Spectre X Simulator は、アナログやミックスシグナル、カスタム IC デザインのシミュレーションの次世代の要望に対処するために開発されました。

### 目次

Introduction.....	1
Emerging Simulation Challenges .....	2
New architectures .....	2
Post-layout challenges in advanced-node designs .....	2
More than Moore.....	3
Dennard's Law .....	3
Introducing Cadence Spectre X Simulator .....	4
Using Spectre X Simulator for Analog and Custom IC Design and Verification.....	4
Massively Distributed Simulation .....	6
Ease of Adoption.....	7
Conclusion.....	7
References.....	8

### Introduction

数年前、私は、90 年代後半に Cadence の IP グループが設計した 10bit のパイプライン ADC を使った顧客の設計を支援しました。この ADC が設計された当時、SINAD (signal-to-noise and distortion) を測定するトップ階層のシミュレーションは、完了までにおおよそ 128 時間を要しました。2015 年に同じシミュレーションを実行すると、単一 CPU 上の実行で、約 10 分で終了します。確かに、シミュレーション時間が向上した理由の半分は、コンピュータ・ハードウェアの性能の進歩に由来します。けれども、改善のその他の半分は、Cadence Spectre Accelerated Parallel Simulator (APS) の進歩によるものです。Spectre Accelerated Parallel Simulator の数値計算エンジンは、シミュレーション時間を短縮しシミュレーションのデザイン・サイズを大きくするように機能改善が続けられました。マルチコア・サーバー上での Spectre Accelerated Parallel Simulator の実行の実際の効果は、過去には不可能だったデザインの検証が可能になったことです。例えば、この ADC の 256 回の Monte Carlo シミュレーションを 16 コア・マシン上で実行すれば、3 時間以内に完了します。

これで、全てのシミュレーションの問題が解決したと思うかもしれませんが、言うまでもなく話はもっと複雑です。私たちに恩恵をもたらす法則は私たちの頭痛の原因でもあります。つまり、ムーアの法則 (Moore's Law) [1]によりシミュレーションの性能とキャパシティが劇的に向上しますが、その一方で、設

計者の生活をさらに「エキサイティング」にするという課題をもたらします。

ムーアの法則の作用から、それがアナログ設計者にどのような影響をもたらしたのかを考えてみます。回路シミュレーションに対するムーアの法則の考慮すべき影響としては、次の 3 つの項目が考えられます。

- デザインへの影響
- プロセス・スケーリングの影響
- More than Moore の影響

これらの各項目は設計全体の技術的な課題を指数関数的に増加させ、これらは設計者にも影響を与えます。アナログ・シミュレータへの依存度を高めるには、回路規模の大幅な増加や解析の課題があっても、シミュレータの性能を向上させる必要があります。

## Emerging Simulation Challenges

SoC 設計の最も重要な影響の 1 つは、デジタルの設計者が使用するのと同じプロセス・ノードを使用して高性能なアナログ IP を設計しなければならないことです。そのため、アナログ設計者が過去の設計で用いた精巧なトランジスタや受動素子を使用せずに、アナログ・デザインを設計しなければなりません。その結果、設計者はディープ・サブミクロン・プロセスや Advanced Node プロセスの機能（即ち、高密度ロジック）を利用してアナログ機能を実装するように、回路構成をアーキテクチャから再び考える必要があります。

### New architectures

これら新しいアーキテクチャは、シミュレータに異なる要件を課します。その一方で、時間領域で線形性とノイズを解析する唯一の方法は、トランジェント解析を実行して結果をフーリエ解析し、時間領域の応答を周波数領域の応答に変換することです。この種の解析は、コンパレータのオフセット電圧の解析から PLL の VCO のキャリブレーション、ループフィルターの周波数の算出[3、4]、さらには、完全デジタル PLL[5、6]まで、さまざまところで使用されます。他方、これらの新しいアーキテクチャは、さまざまな動作モードにおいて正確な相互作用が必要な多くの要素から構成されるため、アナログの機能検証が必要となります。回路シミュレータは、多くの異なる種類のシミュレーションが実行できるように簡単に設定を変更することができるオプションを持つように、高い柔軟性が求められます。

### Post-layout challenges in advanced-node designs

ムーアの法則の二つ目の影響は、回路設計におけるプロセス・スケーリングの影響です。主要なサイズが縮小されるにつれて、インターコネクとデバイスの寄生素子の相対的な影響が増加します。昔から、アナログ設計者は回路性能へのトランジスタの影響を解析するために、プリレイアウトの回路図のシミュレーションを使用してほとんどのデザイン・テストを実行していました。近年の傾向では、Advanced Node の設計の場合、トランジスタ・モデル内に多数のデバイスの寄生素子が含まれることから、たとえレイアウト前のシミュレーションでもポストレイアウトのシミュレーションの様に実行することを考えなければなりません。

Advanced Node トランジスタを用いた高性能なアナログ回路の設計では、寄生素子を含んだシミュレーションの必要性があり、トランジスタと寄生 RC 素子の比率が 1:100 を超える可能性があることから、課

題がさらに複雑になります[7]。SerDes は、特に困難なデザインだと考えられます。SoC にデータ・コンバーターのようなアナログ・ブロックが含まれていなくても、SerDes はデジタル SoC の I/O ブロックとして機能するため、SerDes が必要となります。SerDes は、クロック/データ・リカバリー回路と組み合わせたクロック・ジェネレーターに PLL 回路を使用します。結果として、SerDes の設計では、複数の設計の課題に直面します。それらは、解析されなければならない膨大な寄生素子をもたらす Advanced Node トランジスタで設計されます[8]。さらに、SerDes 設計では、クロック信号の信号品質を維持することが不可欠なことから、ポストレイアウト・シミュレーションが特に重要となります。寄生成分によりクロック・ラインにノイズが混入されると、結果として SerDes の不必要な信号ジッタを生じます。

## More than Moore

ムーアの法則の三つ目の影響は、More than Moore の影響です。これは、新しいアーキテクチャを必要とする可能性がある、より大きく高度に統合された設計に現れる影響です。この影響では、スケールアップを大きくしても、デザインの統合レベルを上げることができません。代替となるのは、高度なパッケージングやスタッキング、新素材によりデザインの統合レベルを上げることです。例えば、3D フラッシュ・メモリーと磁気メモリーの、新しいテクノロジーを考えてみます。3D フラッシュ・メモリーは、単一のメモリー・セルに複数ビットのデータを格納することができます[9、10、11、12]。メモリー・セルへの複数ビットの格納では、SPICE を用いてのみシミュレーションが可能な精巧なプログラムと読み出しアルゴリズムが必要となります。磁気抵抗メモリーは、磁気領域に情報を格納する不揮発性メモリーの種類です。従来の不揮発性メモリーとは異なり、これらのメモリー・セルは電圧ではなく電流を使用してプログラムされます。この違いは小さく見えますが、デザインのシミュレーション方法に大きな影響を与えます[13]。電流の正確なシミュレーションは、SPICE シミュレーションを必要とします。この結果、MRAM 解析を実行できるように SPICE シミュレーションの規模の拡張が必要となります。

## Dennard's Law

ムーアの法則が有名な一方で、アナログ設計に影響するもう一つの「法則」にデナードの法則 (Dennard's Law、デナード・スケールアップや比例縮小則とも呼ばれています) があります。Robert Dennard 氏は「…デナード・スケールアップ則では、一定のエリア・サイズに対するチップ電力の総計はプロセス世代間で同じになる。」と述べています[14]。デジタル回路とは異なり、アナログ回路の消費電力はプロセス・テクノロジーに比例しません。アナログ回路の消費電力を削減するには、新しい回路アーキテクチャとより高度な電源管理技術の開発が不可欠です。デジタルの設計者が UPF (unified power format) [15]などの電源管理するための自動化ツールを使用するのは異なり、アナログ設計者はトランジスタレベルのシミュレーションによりデザインを検証する必要があります。ダイナミック・チェックなどの機能は、ローパワー設計により生じる可能性のある回路の問題を特定することに利用できるように改善が続いています。例えば、パワーダウン中の回路内のフローティング・ゲートは、リーク電流の原因となります。一方で、チェックを使用するには、回路を SPICE シミュレーションする必要があります。回路動作の各モードのみを検証するのではなく、モードを切り替えるときにも適切な動作がされているかを確認する必要があります。これは、FastSPICE のシミュレーションでは不可能な回路の動作の高速かつアナログ精度の検証を要求します。



図 1: Spectre X Simulator vs. Spectre Accelerated Parallel Simulator

## Introducing Cadence Spectre X Simulator

Cadence Spectre X Simulator は、25 年以上にわたり業界をリードする Spectre の実績のあるシミュレーション精度を維持しながら最大 10 倍のパフォーマンス向上を実現する、超並列回路シミュレータです。新しい Spectre X Simulator は、これまでの Cadence のシミュレーション・ソリューションと比較して 5 倍の大規模なデザインを扱うことができ、ポストレイアウトの検証フローにおいて数百万のトランジスタと数十億の寄生素子を持った回路を効果的にシミュレーションできます。新しい Spectre X Simulator は、ミックスシグナル・シミュレーションや RF Option に対応し、実証された精度を持ち、大規模分散シミュレーションに対応した、より高速な実行時間を実現しながら簡単に適用が可能という利点があります。

## Using Spectre X Simulator for Analog and Custom IC Design and Verification

Spectre Circuit Simulator はアナログ設計者が考慮する精度に対処するために開発され、25 年以上にわたりアナログ設計のための信頼されたゴールデン・リファレンスなシミュレータです。Spectre X Simulator は、設計者が期待し頼りにしている Spectre Circuit Simulator の実績のあるシミュレーション精度を継承しています[16]。Spectre Circuit Simulator には、以下の 3 つのエラー・プリセットの設定があります。

- Liberal は、パワー・マネージメント・デザインや精度要求が緩められたアナログ・デザイン向けの精度設定です。
- Moderate は、一般的な多くのアナログ・アプリケーション向けの精度設定です。
- Conservative は、16bit の ADC ダイナミック・レンジのシミュレーションなど、高精度を必要とするアナログ・アプリケーション向けの精度設定です。

これらのエラー・プリセットはアナログ設計者に活用され、シミュレータ・オプションを個別に調整しなくても必要な精度の調整を可能にします。しかし、これまで説明しているように、設計者が実行する必要

があるシミュレーションの種類が増えていることから、Spectre X Simulator では、新しいエラー・プリセットを導入しています。Spectre Circuit Simulator が最初に開発されてから、シミュレーション技術は進歩しています。これにより、Spectre X Simulator の開発とあわせてエラー・プリセットが更新されました。5つのエラー・プリセット (cx、ax、mx、lx、vx) は、Spectre Simulator の実績のあるシミュレーション精度を維持しパフォーマンスを大きく加速しながら、より詳細にシミュレータの制御を可能にします。これらのプリ・セットは以下の様になります。

- vx は、カスタム IC の検証向けの精度設定です。
- lx は、パワー・マネージメント・デザインや精度要求が緩められたアナログ・デザイン向けの精度設定です。
- mx は、一般的な多くのアナログ・アプリケーション向けの精度設定です。
- ax は、高精度なアナログ・アプリケーション向けの精度設定です。
- cx は、ゴールデン・リファレンスの結果を必要とするときの精度設定です。

しかし、シミュレーションの実行時間を削減するだけでは十分ではありません。既に論じているように、デザインはより多くの寄生素子を持ち、ますます大きくなり、シミュレーションのモードは増加し、さらに多くのシミュレーションの実行を必要とします。Spectre X Simulator は、行列演算のキャパシティが拡張され、そのキャパシティは Spectre Accelerated Parallel Simulator と比較して5倍になりました。結果、Spectre X Simulator は、精度を落とすことなく2千万を超えるトランジスタと10億の寄生デバイスを持ったデザインのシミュレーションを可能にします。

コアのシミュレーション技術の改善に加えて、Spectre X Simulator には、設計タスクに対するスマート・シミュレーションのアプローチが組み込まれています。スマート・シミュレーションは、シミュレーションされるデザインに基づいて、必要に応じて、ポストレイアウト・シミュレーションや高耐圧シミュレーション用のテクノロジーを有効にすることで、インテリジェントに最適化し、デザインに適用するシミュレータの機能です。これらの改善による効果は、幅広いデザインの検証時間を改善します。結果は、図 2 を参照ください。

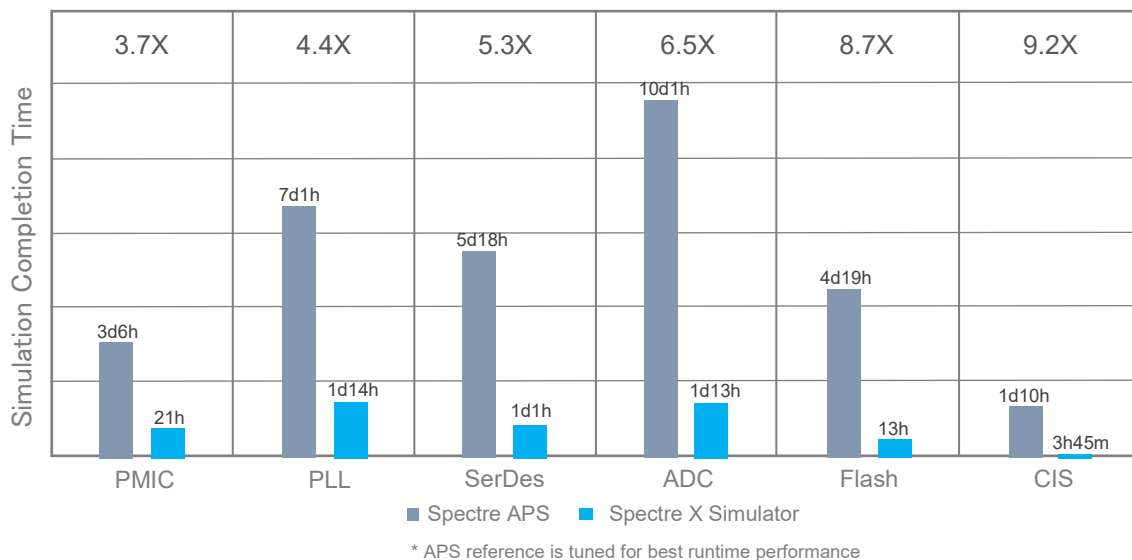


図 2: Spectre X Simulator の検証時間の短縮結果

## Massively Distributed Simulation

Spectre X Simulator は、最新のコンピュータ・ハードウェアを活用して、スケラブルに大規模に分散されたシミュレーションを実現します。この Xscale テクノロジーは、トランジェント解析およびハーモニック・バランス (HB) 解析シミュレーションの効率的な分散を可能にします。Xscale テクノロジーは、異なるマシン上の同時に最大 128 コアを使用したネットワーク上でテストされており、大規模並列実行を可能にして、今日の回路規模の制限を 5 倍に拡大します。シミュレーション・ジョブを分散する前に、シミュレーションの回路行列は部分に分割され、異なるマシン上で計算されます。シミュレーション結果の精度が低下しない様にシミュレーションを分割するために、いくつかの課題を克服しています。

- 関連する複数プロセス間の負荷バランス  
負荷分散は、シミュレーション全体を遅くする単一プロセッサ上で実行されるシミュレータのボトルネックを軽減します。
- プロセッサ間の通信の最適化  
SPICE シミュレーションは単一のタイム・ステップを使用し、ハードウェア全体に分散された回路行列の異なる部分間の接続は各タイム・ステップで情報が共有される必要があることを意味します。

CMOS イメージ・センサーは、分散シミュレーションの効果が得られるデザインの一つの例です。CMOS イメージ・センサーは、ピクセル・アレイから構成されています。画素の各カラムは ADC を含む信号処理部からなるセンサーに接続されています。各信号処理部の伝達関数が他の全てのカラムの伝達関数と一致していない場合、例えば画像の背景の青空の色が変化するなど、不自然な画像になってしまうことがあります。

伝達関数の違いは、電源メッシュの電圧降下によって生じます。そのため、CMOS イメージ・センサーの解析は SPICE シミュレーションにとって難しい課題です。タイミングや電圧での要求される高い精度、デザインは物理的に大規模、シミュレーションではレイアウトの寄生情報を含む必要があります。この組み合わせにより、CMOS イメージ・センサーの検証は、これまで未解決な課題とされてきました。以下の図 3 は、Spectre X Simulator を使用して CMOS イメージ・センサーを分散シミュレーションしたときの速度向上を表しています。シミュレーション時間が 30 倍に速度向上されたことで、1 日半から 1 時間半に短縮されました。

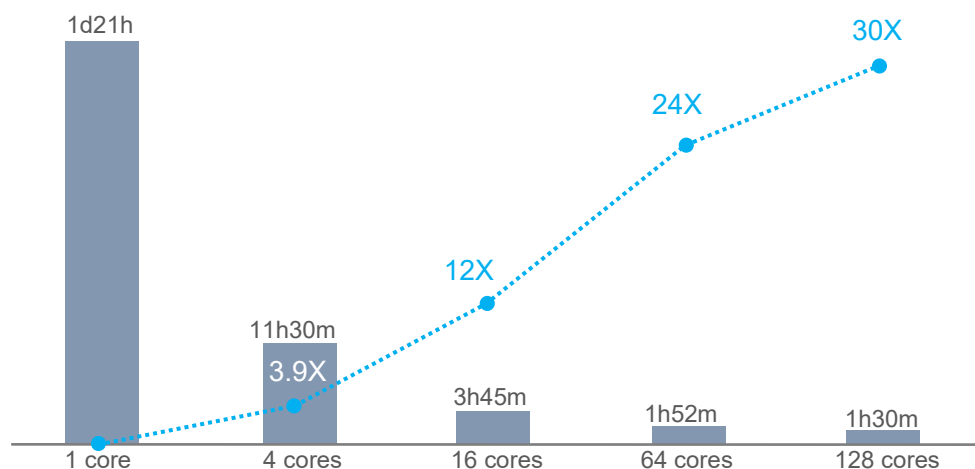


図 3: 分散シミュレーションのパフォーマンス改善

## Ease of Adoption

Spectre X Simulator は、Spectre Circuit Simulation Platform に新しく追加されたシミュレータです。Spectre X Simulator は Spectre Circuit Simulation Platform 上に構築されていることから、Spectre のインフラストラクチャ機能を引き継いでいます。例えば、Spectre ネットリストの読み込み、同じモデルや同じスティミュラスなどのサポートにより、Spectre Accelerated Parallel Simulator の置き換えを可能にし、既存のデザインやテストベンチで、変更や編集を必要としないで Spectre X Simulator の向上されたパフォーマンスやキャパシティの利用が可能です。Spectre X Simulator の導入により、追加のエラー・プリセットを使うことができます。これは、シミュレータを調整することなく、設計要件に基づいて適切にシミュレーションの実行時間と精度の選択が可能な効果のあるモードです。

ムーアの法則とデナードの法則の影響についての項では、新しいアプリケーションに対処するための Spectre X Simulator の必要性を説明しました。メモリーやローパワー・アプリケーションの動作検証のため、追加のエラー・プリセットの提供が必要となります。Spectre X Simulator は、Spectre AMS Designer シミュレータのアナログ・ソルバーとして使用することができ、大規模なミックスシグナル・デザインの検証が可能です。また、Spectre RF Option と一緒に使用してハーモニック・バランス解析の高速化が可能です。

## Conclusion

次世代 SPICE シミュレータである Cadence の Spectre X Simulator は、以下を含む、新たに設計者が直面する課題に対処するように開発されました。

- 解析するトランジスタ数の大幅な増加
- プロセス・スケーリングの影響を軽減するための新しいデザイン・アーキテクチャの要望
- 解析するデバイスと配線の RC 寄生素子の指数関数的な増加

Spectre Accelerated Parallel Simulator と同様に、Spectre X Simulator は既存の Spectre Circuit Simulation Platform 上に構築され、導入コストを最小限にして、新規ユーザーも短期に使い方を習得することが可能です。

Spectre X Simulator には新しいエラー・プリセットが導入されています。これらのエラー・プリセットにより、デザインに合わせてより柔軟なシミュレーション・パフォーマンスと精度の最適化が可能です。Spectre X Simulator エンジンには、デバイス・モデルとポストレイアウト・シミュレーションの新しい最適化機能が組み込まれていますが、実績のあるシミュレーション精度を保ちながらパフォーマンスを向上することが可能です。Spectre X Simulator の行列ソルバーは、従来の行列ソルバーと比較して 5 倍のシミュレーション・キャパシティを持っています。Spectre X Simulator は、スケーラブルな大規模分散シミュレーションの実行が可能です。Spectre X Simulator の Xscale テクノロジーは、最新のコンピュータ・ハードウェアを利用して、異なるマシン上の 128 コアへの効率的な分散シミュレーションを可能にします。Spectre X Simulator は、近年の設計の回路性能の検証の課題に取り組むアナログ設計者およびカスタム IC 設計者の要望に応えるために開発されました。

## References

- 1 G. Moore, "Cramming More Components onto Integrated Circuits," *Electronics*, vol. 38, no. 8, p. 114, 1965.
- 2 M. Miyahara, Y. Asada, D. Paik, and A. Matsuzawa, "A low-noise self-calibrating dynamic comparator for high-speed ADCs," *Proc. IEEE Asian Solid-State Circuits Conf. (A-SSCC)*, Nov. 2008, pp. 269–272.
- 3 Kok-Foong Chong, Lier Siek, Benjamin Lau, "A PLL with a VCO of improved PVT tolerance", in *Integrated Circuits (ISIC) 2011 13th International Symposium on*, pp. 464-467, 2011.
- 4 D. Collins, A. Keady, and R. Farrell, "Fast frequency calibration of VCO's in phase-locked loops," *IET Irish Signals and Systems Conference (ISSC 2010)*, Cork, 2010, pp. 147-151.
- 5 G. Marzin, S. Levantino, C. Samori, and A. L. Lacaita, "2.9 A Background calibration technique to control bandwidth in digital PLLs," *2014 IEEE International Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC)*, San Francisco, CA, 2014, pp. 54-55.
- 6 S. C. Hong, "An all-digital phase-locked loop system with high performance on wideband frequency tracking," *IEEE Trans. on Circuit and Systems*, vol. 52, no. 10, 2009.
- 7 David Axelrad, "What's in the Future for High-Speed SerDes?", Design & Re-Use Magazine, [Online]. Available: <https://www.design-reuse.com/articles/40028/high-speed-serdes.html>. [Accessed April 30, 2019].
- 8 B. Fuller, "Parasitic Extraction Tips for Advanced Nodes," ARM Community SoC Design blog [Online]. Available: <https://community.arm.com/developer/ip-products/system/b/soc-design-blog/posts/parasiticextraction-tips-for-advanced-nodes>. [Accessed April 30, 2019].
- 9 H. Aochi, "BiCS Flash as a Future 3D Non-Volatile Memory Technology for Ultra High Density Storage Devices," 2009 *IEEE International Memory Workshop*, Monterey, CA, 2009, pp. 1-2.
- 10 A. Nitayama and H. Aochi, "Bit Cost Scalable (BiCS) technology for future ultra high density memories," 2013 *International Symposium on VLSI Technology, Systems and Application (VLSI-TSA)*, Hsinchu, 2013, pp. 1-2.
- 11 K. Park et al., "Three-Dimensional 128 Gb MLC Vertical nand Flash Memory With 24-WL Stacked Layers and 50 MB/s High-Speed Programming," in *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 50, no. 1, pp. 204-213, Jan. 2015.
- 12 C. Kim et al., "A 512-Gb 3-b/Cell 64-Stacked WL 3-D-NAND Flash Memory," in *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 53, no. 1, pp. 124-133, Jan. 2018.
- 13 B. Fuller, "Circuit Design Trends: 3D-ICs Extend Scaling," [Online]. Available: [https://community.cadence.com/cadence\\_blogs\\_8/b/fullerview/posts/circuit-design-trends-3d-ics-extend-scaling](https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/fullerview/posts/circuit-design-trends-3d-ics-extend-scaling). [Accessed April 30, 2019].
- 14 R. Dennard, et al., "Design of ion-implanted MOSFETs with very small physical dimensions," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. SC-9, no. 5, pp. 256-268, Oct. 1974.
- 15 M. Ramezani and C. Choi, "A Better Tool for Functional Verification of Low-Power Designs with IEEE 1801 UPF." [Online] Available [https://www.cadence.com/content/dam/cadence-www/global/en\\_US/documents/tools/system-design-verification/low-power-wp.pdf](https://www.cadence.com/content/dam/cadence-www/global/en_US/documents/tools/system-design-verification/low-power-wp.pdf) [Accessed



May 30, 2019]

- 16 H. Xu and A. A. Abidi, "Analysis and Design of Regenerative Comparators for Low Offset and Noise," in *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*.

---

**cādence**<sup>®</sup>

ケイデンスは、電気・電子設計におけるグローバルな革新を可能にし、今日のエレクトロニクス製品を生み出すために重要な役割を果たしています。お客様はケイデンスのソフトウェア、ハードウェア、知的財産 (IP)、ノウハウを活用して、今日のモバイルアプリケーション、クラウドアプリケーション、コネクティビティアプリケーションを設計、検証できます。[www.cadence.com/jp](http://www.cadence.com/jp)

© 2019 Cadence Design Systems, Inc. All rights reserved worldwide. Cadence および Cadence ロゴは Cadence Design Systems, Inc. の米国またはその他の国における登録商標です。その他記載されている製品名および会社名は各社の商標または登録商標です。6294 03/16 SA/LL/PDF